

# SOT23 PNP SILICON PLANAR DARLINGTON TRANSISTORS

## BCV26 BCV46

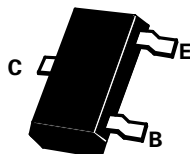
ISSUE 3 – SEPTEMBER 1995

### FEATURES

\* Low saturation voltage

COMPLEMENTARY TYPE – BCV26 - BCV27  
BCV46 - BCV47

PARTMARKING DETAILS – BCV26 - ZFD  
BCV46 - ZFE



### ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS.

PARAMETER	SYMBOL	BCV26	BCV46	UNIT
Collector-Base Voltage	$V_{CBO}$	-40	-80	V
Collector-Emitter Voltage	$V_{CEO}$	-30	-60	V
Emitter-Base Voltage	$V_{EBO}$	-10		V
Peak Pulse Current	$I_{CM}$	-800		mA
Continuous Collector Current	$I_C$	-500		mA
Base Current	$I_B$	-100		mA
Power Dissipation at $T_{amb}=25^{\circ}C$	$P_{tot}$	330		mW
Operating and Storage Temperature Range	$T_j; T_{stg}$	-55 to +150		$^{\circ}C$

### ELECTRICAL CHARACTERISTICS (at $T_{amb} = 25^{\circ}C$ unless otherwise stated).

PARAMETER	SYMBOL	BCV26		BCV46		UNIT	CONDITIONS.
		MIN.	MAX.	MIN.	MAX.		
Collector-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)CBO}$	-40		-80		V	$I_C=100\mu A$
Collector-Emitter Breakdown Voltage	$V_{(BR)CEO}$	-30		-60		V	$I_C=10mA$ *
Emitter-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)EBO}$	-10		-10		V	$I_E=10\mu A$
Collector Cut-Off Current	$I_{CBO}$		-100		-100	nA nA $\mu A$ $\mu A$	$V_{CB} = -30V$ $V_{CB} = -60V$ $V_{CB} = -30V, T_{amb} = 150^{\circ}C$ $V_{CB} = -60V, T_{amb} = 150^{\circ}C$
Emitter Base Cut-Off Current	$I_{EBO}$		-100		-100	nA	$V_{EB} = -4V$
Collector-Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(sat)}$		-1.0		-1.0	V	$I_C = 100mA, I_B = -0.1mA$ *
Base-Emitter Saturation Voltage	$V_{BE(sat)}$		-1.5		-1.5	V	$I_C = 100mA, I_B = -0.1mA$ *
Static Forward Current Transfer Ratio	$h_{FE}$	4K 10K 20K 4K		2K 4K 10K 2K			$I_C = 100\mu A, V_{CE} = -1V \dagger$ $I_C = 10mA, V_{CE} = -5V$ * $I_C = 100mA, V_{CE} = -5V$ * $I_C = 500mA, V_{CE} = -5V$ *
Transition Frequency	$f_T$	200 Typical		200 Typical		MHz	$I_C = 50mA, V_{CE} = -5V$ $f = 20MHz$
Output Capacitance	$C_{obo}$	4.5 Typical		4.5 Typical		pF	$V_{CB} = -10V, f = 1MHz$

\*Measured under pulsed conditions. Pulse width=300 $\mu s$ . Duty cycle  $\leq 2\%$

Spice parameter data is available upon request for these devices † Periodic Sample Test Only.

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9